

本期封面



2000年4期

栏目:

DOI:

论文题目: 微型NiFe磁性薄膜元件中Neel畴壁极性的转变过程

作者姓名: 余晋岳 魏福林

工作单位: 上海交通大学信息存储研究中心国家教育部薄膜与微细技术重点实验室, 上海200030

通信作者: 余晋岳

通信作者Email:

文章摘要: 观察和分析了 $300\mu\text{m} \times 40\mu\text{m} \times 40\text{nm}$ 的NiFe磁性薄膜元件在难轴方向反磁化时磁畴结构转变特别是Neel畴壁从正极性壁(N+)转变为负极性壁(N-)的全过程. 磁畴结构的转变包含畴壁合并, 封闭畴转变, 钩形畴转变及Neel畴壁极性转变等变的可逆因素, 对畴壁极性转变的身份种方式(即 $N^+ \rightarrow N^-$ 直接转变及经由十字壁(Ne t) r $N^+ \rightarrow N^-$ 间接转变)进行了分析讨论.

关键词: 磁性薄膜元件 反磁化

分类号: 0484 TM27

关闭